

## Market News

### **Sechste Generation von CoolSiC™ Schottky-Dioden 650 V von Infineon für schnelles Schalten**

München, 26. September 2017 – Die Infineon Technologies AG stellt die CoolSiC™ Schottky Diode 650 V G6 vor. Die neueste Entwicklung innerhalb der CoolSiC Diodenfamilie basiert auf den herausragenden Merkmalen der fünften Generation. Sie sind deshalb gekennzeichnet durch Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienzsteigerung. Die CoolSiC G6 Dioden eignen sich insbesondere für die CoolMOS™ 7 Familien der Spannungsklassen 600 V und 650 V. Sie zielen auf aktuelle und zukünftige Anwendungen in den Bereichen [Server-](#), [PC-](#) und [Telekom-Stromversorgungen](#) sowie [PV-Wechselrichter](#).

Die CoolSiC Schottky Diode 650 V G6 verfügt über ein neues Layout, eine neue Zellstruktur und ein neues proprietäres Schottky-Metallsystem. Daraus resultiert ein branchenweiter Bestwert für die Durchlassspannung  $V_F$  (1,25 V) und eine Kennzahl für  $Q_C \times V_F$ , die um 17 Prozent niedriger liegt als bei der Vorgängergeneration. Wegen der besonderen Eigenschaften des Siliziumkarbids schaltet die Diode temperaturunabhängig und weist keine Sperr-Erholladung auf.

Das Design des Bausteins bietet einen verbesserten Wirkungsgrad über alle Lastfälle hinweg bei gleichzeitig erhöhter Leistungsdichte des Systems. Die CoolSiC Schottky Diode 650 V G6 sorgt daher für einen reduzierten Kühlungsbedarf, erhöhte Systemzuverlässigkeit und extrem schnelles Schalten. Die neue SiC-Diodengeneration weist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

### **Verfügbarkeit**

Die CoolSiC Schottky Diode 650 V G6 ist ab sofort lieferbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter [www.infineon.com/cool-sic-g6](http://www.infineon.com/cool-sic-g6).